

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0593U000187

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 28-02-2000

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Тартачник Владимир Петрович

2. Тартачник Владимир Петрович

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: dashboard/okd.okd_type_names.0

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 01.04.10

Назва наукової спеціальності: Фізика напівпровідників і діелектриків

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 23-04-1993

Спеціальність за освітою: 2016

Місце роботи здобувача: Інститут ядерних досліджень НАН України

Код за ЄДРПОУ: 5416960

Місцезнаходження: 252028 г. Киев, пр. Науки 47

Форма власності:

Сфера управління: НАН України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 068.16.01

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Институт ядерных исследований НАН Украины

Код за ЄДРПОУ: 5416960

Місцезнаходження: 252028 г. Киев, пр. Науки 47

Форма власності:

Сфера управління: НАН Украины

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 47.09.29

Тема дисертації:

1. Радиационные дефекты в полупроводниковых фосфидах A_3B_5 и A_2B_5
- 2.

Реферат:

1. Объект исследования: Бинарные полупроводники - фосфид галлия, фосфид индия, дифосфид цинка и дифосфид кадмия. Цель исследования: Получение детальной информации о природе дефектных состояний, возникающих при облучении в полупроводниковых фосфидах, определение специфики дефектообразования в анизотропных кристаллах, получение сведений о механизмах деградации и восстановления физических свойств, разработка способов управления этими процессами. Методы исследования и аппаратура: Метод аннигиляции позитронов, НСГУ, оптическое поглощение, фотопроводимость, электро- и фотолюминесценция, Эффект Холла, микротвердость, отжиг. Теоретические результаты и новизна: Расчитаны сечения образования точечных дефектов и областей разупорядочения в фосфиде галлия. Впервые получены пороговые образования радиационных дефектов в CaP , исследованы их свойства. Получены основные характеристики и параметры областей разупорядочения, изучены длинновременные релаксационные процессы в облученных CaP и InP . Практические результаты и новизна: Разработан способ получения низкоомного ZnP_2 , способ увеличения прозрачности CaP в видимой области

спектра, способ ультразвукового восстановления интенсивности свечения фосфидо-галлиевых светодиодов, предложен режим радиационно-термической обработки кристаллов СаР, улучшающий их однородность, сконструировано устройство для радиационной обработки образц. Предмет и степень внедрения: Способ увеличения прозрачности кристаллов фосфида галлия планируется внедрить на заводе Чистых металлов (г.Светловодск), устройство для облучения - в Институте ФХ АН Украины. Сфера (область) использования: Полупроводниковая микро- и оптоэлектроника, квантовая электроника, ядерное легирование полупроводников, ионная имплантация.

2.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Бабич В.М.

2. Бабич В.М.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Грушка Г.Г.
2. Грушка Г.Г.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Корбутяк Д.В.
2. Корбутяк Д.В.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Ткач М.В.

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Ткач М.В.

